مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۲۳، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۴۰۲ DOI: 10.47176/ijpr.23.4.51690

<u>زوهش فيرد</u>

# بهینه سازی برخی پارامترهای ورودی یک لیزر تپی TEA CO<sub>۲</sub> بر پایهٔ معادلات تعمیم یافتهٔ لاندائو-تلر

## سمیه پناهی بخش، عزیزمراد کوشکی ، و زهره رجبی

پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری کوانتومی، صندوق پستی : 836–14395، تهران

پست الكترونيكي: akoushki@aeoi.org.ir

(دریافت مقاله: ۷۰/ ۳۰/ ۱۴۰۲ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳)

#### چکیدہ

در این مقاله، مدل سینتیک شش دمایی بر اساس معادلات تعمیم یافتهٔ لاندائو-تلر برای بهینه سازی برخی پارامترهای ورودی یک لیزر تپی COT TEA به کار رفته است. این مدل با در نظر گرفتن معادلات حاکم بر محیط تخلیهٔ الکتریکی برای محاسبهٔ چگالی الکترونها، به صورت عددی حل شده است. در این پژوهش، برای اولین بار تفکیک مولکول COT و تولید CO به صورت یک معادلهٔ تحول زمانی با سایر معادلات دینامیکی آهنگ لیزر جفت شده است. رفتار زمانی جریان و ولتاژ تخلیه و توان تپ خروجی لیزر، در نسبت آمیزهٔ گازهای TEA به ترونها، به شد. همچنین، مقدار بهینهٔ پارامترهای ورودی شامل بازتابندگی آینهٔ خروجی، ظرفیت خازن پیش یونش و ظرفیت و ولتاژ شارژ خازن ذخیره برای بهدست آوردن بیشینهٔ قلهٔ توان خروجی محاسبه شد. نتایج بهدستآمده در طراحی بهینهٔ نوسانگرهای TEA COT بسیار حائز اهمیت است. **واژههای کلیدی**: لیزر COT محاله محاط گازی، تفکیک COT، مدل سینتیکی شش دمایی، معادلات لاندائو – تار

#### ۱. مقدمه

لیزر گاز کربنیک یکی از مهم ترین لیزرهای گازی مولکولی با کاربردهای فراوان است. از اینرو، مطالعات زیادی روی آن انجام گرفته است. در حالی که بیشتر لیزرهای گازی بازدهی حدود چند دهم درصد دارند، لیزر گاز کربنیک بازدهی به اندازهٔ چند ده درصد دارد. لذا یک لیزر کوچک از این نوع میتواند دهها وات توان تولید کند [۱–۳]. به دلیل باریک بودن خط جذبی در گازها، روش دمش اپتیکی برای این لیزرها مناسب نیست و از تخلیهٔ الکتریکی برای دمش

و توانهای متفاوت با انواع دمش، اعم از DC و بسامد رادیویی (RF) جهت کاربردهای پزشکی، صنعتی، نظامی، بینابنگاری و غیره ساخته شده است. لیزرهای گاز کربنیک مانند بسیاری از انواع لیزرها در هر دو مد پیوسته و تپی کار میکنند. در میان انواع لیزرهای گازکربنیک، لیزرهای تپی گازکربنیک برانگیختهٔ عرضی فشار جوی (TEA) به خاطر کاربردهای فراوان، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. و بهطور گسترده در کاربردهای علمی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند [۴–۹]. این دسته از لیزرهای گاز کربنیک همان طور که از نامش بر میآید، در محدودهٔ فشار حدود یک اتمسفر کار میکند و تخلیهٔ

<sup>1.</sup> Transverse Excited Atmospheric

قادر به تولید تپهایی با انرژی بسیار بالا در واحد حجم تخلیه است.

لیزرهای گاز کربنیک TEA عموماً تپهای با قلهٔ توان بالا و پهنای تپ کوتاه (۱۰۰–۲۰۰ نانوثانیه) در ناحیهٔ فراقرمز میانی تولید میکنند. از اینرو، برای بسیاری از کاربردها نظیر جداسازی ایزوتوپی لیزری [۱۰–۱۲]، آشکارسازی نوری و فاصلهیابی جوی [۱۳ و ۱۴]، از بین بردن آلودگیهای رادیواکتیو سطوح [۱۵] مورد استفاده قرار می گیرند.

برای لیزر گاز کربنیک وارونی جمعیت بین گذارهای ارتعاشی – چرخشی حالت پایهٔ الکترونی مولکول کربن دیاکسید ایجاد میشود. ایجاد جمعیت در تراز بالای لیزری در خلال تخلیهٔ الکتریکی در مخلوط گازی شامل کربن دیاکسید صورت می گیرد. گازهای دیگری مثل هلیم و نیتروژن به دلیل اثرات مطلوبی که بر همگن بودن تخلیه یا فرایندهای انتقال انرژی دارند، به کربن دی اکسید اضافه شده و باعث می شوند بازدهی لیزر افزایش یابد.

مولکولهای نیتروژن در محیط تخلیهٔ الکتریکی، در اثر برخورد الکترونها تحریک میشوند که برانگیختگی مولکولهای نیتروژن با این روش، فرایند بسیار مؤثری است. در اثر برخورد مولکولهای برانگیختهٔ نیتروژن با مولکولهای کربن دیاکسید، انتقال انرژی تشدیدی بین این دو مولکول صورت می گیرد. در این صورت دمش تراز بالایی بسیار مؤثر خواهد بود و این امر بازدهی بالای لیزر ۲۰۵۰ را توجیه میکند.

هنگامی که یک لیزر گاز کربنیک برانگیختهٔ عرضی فشار جوی بسته (sealed-off) طراحی می شود یکی از موضوعات اصلی و ذاتی این واقعیت است که در طی فرایند دمش لیزر، الکترون-های ناشی از تخلیهٔ الکتریکی با مولکول ۲OT برخورد کرده و آن را تجزیه می کنند و گازهای آلایندهای که به وسیلهٔ واکنش-های شیمیایی پلاسما به وجود می آیند در محفظهٔ لیزر بسته انباشته شده و باعث ناپایداری محیط تخلیهٔ الکتریکی، کاهش طول عمر لیزر و کاهش توان خروجی لیزر می شوند [۶۴]. واکنش اصلی تفکیک مولکول کربن دی اکسید در محیط تخلیهٔ الکتریکی لیزر ۲OT به صورت زیر است:

 $\mathrm{CO}_{\mathrm{Y}} + e^{-} \rightarrow \mathrm{CO} + \mathrm{O} + e^{-}$ 

آهنگ تولید مونوکسیدکربن به غلظت اولیهٔ مولکول ۲ON و چگونگی توزیع انرژی الکترونها وابسته است. مولکول مونوکسیدکربن دوقطبی الکتریکی دائمی دارد، پس احتمال تحریک حالتهای ارتعاشی آن با برخوردهای الکترونی زیاد است و میتواند با ۲ON تبادل انرژی انجام دهد. البته بین CO و ۲N نیز امکان تبادل انرژی تشدیدی وجود دارد. بهعلاوه CO به دلیل داشتن دوقطبی الکتریکی میتواند تابش کند و انرژی وارد شده به محیط از طریق فرایند دمش را تلف کند.

همان طور که گفته شد <sub>۲</sub>N به <sub>۲</sub>OC اضافه می شود، تا آهنگ برانگیختگی تراز بالایی افزایش یابد. پس از آن He نیز به این مخلوط افزوده می شود، تا زمان واهلش تراز پایین لیزری کاهش یابد. همچنین، هلیوم در اثر برخورد با الکترونها مقداری از انرژی آنها را کسب می کند و باعث می شود انرژی این الکترونها در محدودای که برای عمل لیزر مناسب است، تنظیم شود. در لیزرهای تپی وجود هلیوم در همگن کردن هر چه بیشتر محیط تخلیهٔ الکتریکی نقش مهمی دارد.

لیزر گاز کربنیک تپی TEA با یک آغازگر باریک (۲۰۰۱۰) یک دنبالهٔ بلند (µs) تولید میکند. به دلیل دمش برخوردی مولکولهای ۲O7 توسط مولکولهای N2، بیشتر انرژی تپ در بخش دنبالهٔ تپ لیزری قرار میگیرد. وقتی پهنای تپ کوتاهتر مد نظر باشد، لازم است تا نیتروژن از مخلوط گازی حذف شود، اما این مسئله به کاهش شدید بازدهی لیزر میانجامد. در عمل مقدار کمی از نیتروژن را میتوان به مخلوط گازی اضافه کرد تا لیزر در یک بازدهی متوسط و با تولید تپ کوتاهتر و تقریباً بدون دنباله بلند کار کند [۱۷].

کاربردهای مختلف، نیاز به شکل تپ و مشخصات خروجی متفاوتی دارد. با تغییر مشخصات ورودی، نرخ دمش و آمیزهٔ گازهای لیزری امکان تغییر خروجی لیزر و کنترل آن وجود دارد [۱۸]. تاکنون برای تعیین و کنترل پارامترهای خروجی لیزر، مدلهای زیادی نظیر مدلهای چهار، پنج و شش دمایی پیشنهاد شدهاند. در واقع مدلهای چهار و پنج دمایی حالتهای خاصی از مدل شش دمایی هستند.



شکل ۱. نمودار ترازهای انرژی لیزر CO۲ .

مدل شش دمایی یک مدل جامع سینتیکی است که تقریباً تمام گذارهایی که بین ترازهای ارتعاشی مختلف رخ میدهد را در نظر می گیرد و در حال حاضر برای توصیف فرایندهای سینتیکی لیزر COr به عنوان یک مدل قدرتمند استفاده می شود [۱۹].

با این حال، در بیشتر کارهایی که بر روی شبیهسازی دینامیکی لیزر ۲O۲ به استفاده مدل شش دمایی انجام شده است، از یک معادله تجربی برای توزیع چگالی الکترون استفاده میکند. استفاده از معادله تجربی برای محاسبه چگالی الکترونها، عامل برخی از عدم تطابقهای شناخته شده بین نتایج مدلسازی و نتایج تجربی است. از این رو، ولین و شاید اساسیترین گام در زمینه شبیهسازی پارامترهای خروجی یک لیزر تپی ۲CO TEA، محاسبه استفاده از معادل سازی محیط تخلیه باشد. در این پژوهش، با استفاده از معادل سازی محیط تخلیه باشد. در این پژوهش، با الکترونی RLC، چگالی الکترونهای محیط تخلیه محاسبه شده و به تحلیل برخی رفتارهای الکتریکی و بهینه سازی شده و به تحلیل برخی رفتارهای الکتریکی و بهینه سازی پارامترهای خروجی لیزر می پردازیم.

در مقاله ترابی و همکارانش [۲۰]، برای شبیه سازی لیزر ۲O۲ TEA با پیش یونش UV آرایه سوزنی، رفتار زمانی تپ جریان تخلیه با در نظر گرفتن ویژگیهای الکتریکی مدار تخلیه و همچنین هندسه پیش یونش، همراه با مدل شش دمایی برای شبیهسازی فرایند انتشار دینامیکی لیزر در نظر گرفته شد که منجر به توافق خوبی با دادههای تجربی در مورد شکل تپ و انرژی لیزر شد. در کار بعدی آنها، نتایج مدلسازی با در نظر

گرفتن نقش تعیین کننده فرایندهای دینامیکی چرخشی بهبود یافت [۲۱].

در این مقاله، علاوه بر در نظر گرفتن مدار تخلیه برای محاسبهٔ چگالی الکترون، آهنگ تغییر غلظت مولکول CO ناشی از تفکیک ۲CO به صورت دینامیکی با سایر معادلات تحول زمانی چگالیهای انرژی شیوههای ارتعاشی لیزر کربن دیاکسید جفت شده است. ضروری است که آهنگ تغییر غلظت ۲OT به صورت تحول زمانی با معادلات آهنگ لیزر جفت شود زیر این کار منطبق بر واقعیت حاکم بر لیزر است. با این وجود، در تمام گزارشهای قبلی غلظت مولکول ۲OT به صورت ثابت و با گزارشهای قبلی غلظت مولکول ۲OT به صورت ثابت و با این امر برخلاف دینامیک حاکم بر محیط تخلیهٔ الکتریکی لیزر این امر برخلاف دینامیک حاکم بر محیط تخلیهٔ الکتریکی لیزر تیی TEA CO<sub>7</sub> بسته منطبق بر واقعیت است.

رفتار زمانی پارامترهای خروجی لیزر، همچنین قلهٔ توان و استخراج انرژی بهینه در آمیزهٔ گازی با نسبت ۱:۱:۲بهدست آمده است. نتایج بهدستآمده، راهنمای خوبی برای طراحی بهینه نوسانگرهای TEA CO<sub>7</sub> برای کاربردهای خاص است و تعیین پارامترهای لیزری برای کنترل شکل تپ را با دقت بالا و سازگاری مناسب امکانپذیر می سازد.

### ۲. تحلیل نظری و معادلات آهنگ

در این مقاله، برای شبیهسازی لیزر TEA CO<sub>۲</sub> از مدل سینتیک شش دمایی توسعه یافتهٔ لاندائو-تلر که بر پایهٔ چگالیهای انرژی شیوههای ارتعاشی ترازهای درگیر در فرایند لیزرند ، استفاده شده است [۲۰ و ۲۱]. نمودار ترازهای ارتعاشی سامانهٔ نشان داده شده است. در این شکل، فرایندهای اصلی نشان داده شده است. در این شکل، فرایندهای اصلی برانگیختگی و فرو افت لیزر مورد استفاده در مدل مشاهده میشود. فرضهای اصلی که در مدل حاضر در نظر گرفته شده شامل موارد زیر است: پهن شدگی خط همه گذارهای ارتعاشی-چرخشی به دلیل فشار گاز بالا، به صورت پهن شدگی فشاری همگن درنظر

$$\frac{dP_{co}}{dt} = \gamma k N_e P_{co} , \qquad (4)$$

آهنگ تولید کربنمونوکسید به صورت زیر است:

$$\begin{split} & \mathcal{Z}_{0} \text{tish additional stress} \\ & \mathcal{Z}_{0} \text{tish additional stress} \\ & (1) \quad \tau_{0}(\{\alpha\}) \quad \text{lic(2) ylling stress} \\ & \tau_{0}(\{\alpha\}) \quad \text{lic(2) ylling stress} \\ & \tau_{0}(\{\alpha\}) \quad \text{tic(2) ylling stress} \\ & \tau_{0}(\{\alpha\}) \quad \text{tic(2) ylling stress} \\ & \mathcal{Z}_{0} \text{tish additional stress} \\$$

$$\begin{aligned} \frac{dL_{\tau}}{dt} &= N_e(t) f N_{co_{\tau}} h v_{\tau} x_{\tau}(T) + \frac{E_{\tau} - E_{\tau}(T_{\tau})}{\tau_{\tau_{\tau}}(T_{\tau})} \\ &+ \left(\frac{h v_{\tau}}{h v_{\tau}}\right) \frac{E_{\tau} - E_{\tau}(T, T_{\tau}, T_{\tau})}{\tau_{\tau}(T, T_{\tau}, T_{\tau})} - \frac{E_{\tau} - E_{\tau}(T)}{\tau_{\tau_{\star}}(T)} \\ &+ \left(\frac{h v_{\tau}}{h v_{\flat}}\right) \frac{E_{\flat} - E_{\flat}(T, T_{\tau}, T_{\tau})}{\tau_{\flat}(T, T_{\tau}, T_{\tau})}, \end{aligned}$$
(Y)

$$\begin{aligned} \frac{dE_{\tau}}{dt} &= N_e(t) f N_{co_{\tau}} h v_{\tau} x_{\tau}(T) - \frac{c h v_{\tau} \Delta N W U_{\nu}(t)}{h} \\ &- \frac{E_{\tau} - E_{\tau}(T, T_{\tau}, T_{\tau})}{\tau_{\tau}(T, T_{\tau}, T_{\tau})} - \frac{E_{\tau} - E_{\tau}(T_{\tau})}{\tau_{\tau\tau}(T)} \\ &+ (\frac{h v_{\tau}}{h v_{\flat}}) \frac{E_{\flat} - E_{\flat}(T, T_{\tau})}{\tau_{\flat}(T, T_{\tau})}, \end{aligned}$$
(Y)

$$\begin{aligned} \frac{dE_{\star}}{dt} &= N_e(t) f N_{N_{\star}} h v_{\star} x_{\star}(T) - \frac{E_{\star} - E_{\star}(T_{\star})}{\tau_{\star \star}(T)} \\ &+ \left(\frac{h v_{\star}}{h v_{\Delta}}\right) \frac{E_{\Delta} - E_{\Delta}(T, T_{\star})}{\tau_{\Delta \star}(T, T_{\star})}, \end{aligned} \tag{(f)}$$

$$\begin{aligned} \frac{dE_{\diamond}}{dt} &= N_e(t)(1-f)N_{co_{\uparrow}}hv_{\diamond}x_{\diamond}(T) \\ -\frac{E_{\diamond}-E_{\diamond}(T,T_{\tau})}{\tau_{o^{\tau}}(T,T_{\tau})} - \frac{E_{\diamond}-E_{\diamond}(T,T_{\tau},T_{\tau})}{\tau_{\diamond}(T,T_{\tau},T_{\tau})} \\ -\frac{E_{\diamond}-E_{\diamond}(T,T_{\tau})}{\tau_{o^{\tau}}(T,T_{\tau})}, \end{aligned}$$

$$(\Delta)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{E_{i} - E_{i}(T)}{\tau_{i}(T)} + \frac{E_{i} - E_{i}(T)}{\tau_{i}(T)}$$



$$\Delta N = N_{\ldots} P(J(\circ \circ 1)) - \frac{\gamma J + \gamma}{\gamma J + \gamma} N_{\gamma \ldots} P(J+1), \qquad (1 \circ )$$

در این رابطه

$$N_{s,v} = f N_{COY} \exp(-h\nu_{\gamma}/kT_{\gamma})Z,$$

$$N_{s,v} = f N_{COY} \exp(-h\nu_{\gamma}/kT_{\gamma})Z,$$
(11)

تابع پارش ارتعاشی در این روابط از معادلهٔ زیر بهدست می اید:  

$$Z = [1 - \exp(-hv_1/kT_1)]^{-1} [1 - \exp(-hv_1/kT_1)]^{-7}$$
[1 - exp(-hv\_1/kT\_1)]^{-1}

$$P(J) = \left(\frac{hB_{v}c}{kT}\right) (\gamma J + \gamma) \exp\left[\frac{-hcB_{v}J(J + \gamma)}{kT}\right], \qquad (\gamma \gamma)$$

$$\Delta v_L = \sum_i \left[ \frac{N_i Q_i}{\pi} \left( \frac{\Lambda kT}{\pi \mu_i} \right)^{\vee \gamma} \right], \tag{14}$$

$$P_{out} = -\frac{A}{\gamma} \cdot \left( \ln R \right) \cdot I_{\nu} \cdot \frac{\gamma - R_{out} - K_{loss}}{\gamma - R_{out}}, \qquad (10)$$

## ۳. مدار تخلیهٔ الکتریکی لیزر و معادلات حاکم بر آن

برای مطالعهٔ نظری لیزر تپی گازکربنیک و شبیه سازی آن حل دقیق مدار تخلیهٔ الکتریکی ضروری است. معمولاً از مدار شبکهٔ تشکیل تپ (PFN) برای دمش این لیزر استفاده میکنند. در این کار نیز این مدار برای تخلیهٔ الکتریکی لیزر TEA CO<sub>7</sub> درنظر گرفته شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم بر مدار با استفاده از قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف نوشته میشود. شکل ۲ مدار الکتریکی معادل برای تخلیهٔ الکتریکی لیزر CO<sub>7</sub> تپی را نشان میدهد.

در این شکل L<sub>7</sub>=۶۰۰*nH* ، C<sub>7</sub>= ۸*nF* ،C<sub>7</sub>=*۴۳ nF* و μμ R<sub>1</sub>=۰/۰ ۱۵ Ω ، L=1*۵*۰*nH* ، R=۱۰Ω ،V<sub>0</sub>=۴۵ KV ، L<sub>1</sub>=۰/۲ (مقاومت تایروترن) و I<sub>1</sub> ،V<sub>d</sub> و I<sub>2</sub> به ترتیب ولتاژ تخلیه، جریان تخلیه و جریان کل و R<sub>d</sub> مقاومت پلاسمای تخلیه هستند.

با توجه به شکل ۲، معادلات دیفرانسیل حاکم بر مدار با استفاده از قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف به صورت زیر نوشته میشوند:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{V - IR}{L},\tag{19}$$

$$\frac{dI_{\rm Y}}{dt} = \frac{V_{\rm Y} - V_{\rm I}}{L_{\rm Y}},\tag{1V}$$

$$\frac{dV_1}{dt} = \frac{I_{\gamma} - I_1}{C_1},\tag{1A}$$

$$\frac{dV_{\gamma}}{dt} = -\frac{I_{\gamma}}{C_{\gamma}},\tag{19}$$

$$\frac{d(I-I)}{dt} = \frac{V-V}{L} - \frac{V-IR}{L} - \frac{V-(I-I)R}{L}, \qquad (\Upsilon \circ)$$

$$V_{AB} = L\frac{dI_{\gamma}}{dt} - L\frac{dI_{\gamma}}{dt} + R(I_{\gamma} - I_{\gamma}), \qquad (\gamma\gamma)$$

$$\frac{dR_d}{dt} = B - ZR_d , \qquad (\Upsilon\Upsilon)$$

$$Z = A_{1}.P_{t}.v_{d}.\exp\left\{D\frac{I_{1}.R_{d}}{P_{t}.d}\right\}, B = \frac{\beta_{eff}.d}{e.\mu_{e}.S}$$
در این روابط میشوند. چگالی الکترونها در محیط تخلیه از رابطهٔ زیر محاسبه می شود:

$$N_e = \frac{I_v}{A \cdot e \cdot V_d} , \qquad (\Upsilon \Upsilon)$$

در این رابطه، e بار الکترون، A مساحت سطح الکترود تخلیه و Va=۱۲×۱۰<sup>۶</sup> cm/sec سرعت کاتورهای الکترونها است.

#### ۴. نتاج شبیهسازی و محاسبات

معادلات دینامیکی (۱) تا (۶) با معادلهٔ تحول زمانی فوتونونهای داخل کاواک لیزر و معادلات حاکم بر مدار تخلیهٔ الکتریکی لیزر برای محاسبهٔ چگالی الکترونها (۱۶) تا (۲۳)) جفت شده و به صورت عددی و به روش رانگ-کوتای مرتبهٔ ۴ به کمک نرم افزار متلب حل شدند. در این محاسبات، نسبت آمیزهٔ گازی ۲۰:۱:۲ها حل شدند. در این محاسبات، نسبت طول بازآواگر اپتیکی ۲۵۰۰۳ له اتلاف آینهها ۵/۰٪= بهنای بازتابندگی آینهها ۶۵٪=R، طول موج نوسان  $\mu q /۰ 1=x$  پهنای الکترودها و فاصلهٔ بین الکترودها هر کدام ۲۳ ۲۰ و ولتاژ اولیهٔ ۲۵۰۰۰۷ درنظر گرفته شدند.

شکل ۳ نمودار رفتار زمانی ولتاژ تخلیهٔ شبیه سازی شده و شکل ۴ منحنی تغییرات جریان تخلیه بر حسب زمان با استفاده از معادلات حاکم بر تخلیه را نشان میدهد. همانگونه که در شکل ۴ نشان داده شده است، با اعمال ولتاژ مورد نیاز برای شکست گاز، این فرایند در طی ۲/۰ میکروثانیه در حجم تخلیه رخ میدهد در طی این زمان قلهٔ جریان پلاسما رخ داده و مقاومت پلاسما به کمترین میزان میرسد. سپس ولتاژ و جریان شروع به افت میکنند و از آنجایی که مقاومت پلاسما بی نهایت نیست، ولتاژ به مقدار غیرصفر در طی ۴ میکروثانیه میرسد.

تغییرات زمانی توان خروجی نیز بهدست آمد و نمودار آن در شکل ۵ نشان داده شده است. مقدار قلهٔ توان خروجی برای ورودیهای داده شده و مدار تخلیهٔ الکتریکی شکل ۲، ۱۰<sup>۶</sup> ۱۲/۴۵×۱۲/۴۵ وات بهدست میآید.

پس از آن بهینه سازی قلهٔ توان خروجی لیزر مورد شبیه سازی قرار گرفت. برای بهینه سازی نتایج در محاسبات، تمام پارامترها به جز متغیر مورد نظر ثابت در نظر گرفته شدند. ابتدا تغییرات توان خروجی برحسب تغییرات بازتابندگی آینهٔ خروجی محاسبه شد و نمودار آن در شکل ۶ داده شده است. همانطور که مشاهده می شود قلهٔ توان خروجی در بازتابندگی ۷۲٪=R بهدست می آید.

پس از آن تغییرات قلهٔ توان خروجی بر حسب ظرفیت خازن پیش یونش محاسبه شد که در شکل ۷ نشان داده شده است. همانطور که از شکل بالا مشاهده می شود تغییرات ظرفیت خازن پیش یونش در بازهٔ ۵ تا ۴۰ نانوفاراد رسم شده است و بهینه قلهٔ توان خروجی برابر ۲۵ نانوفاراد برای ظرفیت خان پیش یونش بهدست آمد. همانطور که نتایج نشان می دهد بهینه ظرفیت خازن پیش یونش اثر مهمی بر بهدست آوردن توان خروجی بیشینه در شرایط ورودی یکسان به همراه دارد و لازم است در طراحی، ساخت و چیدمان لیزر محاسبه و شبیه سازی شود.

در ادامه، تغییرات قلهٔ توان خروجی بر حسب ظرفیت و ولتاژ خازن ذخیره محاسبه شد. شکلهای ۸ و ۹ به ترتیب نمودارقلهٔ توان خروجی بر حسب ظرفیت و ولتاژ شارژ خازن ذخیره را نشان میدهند.

شکلهای ۸ و ۹ نشان میدهند بر خلاف خازن پیش یونش، در مورد خازن ذخیرهٔ ولتاژ شارژ به شدت بر قلهٔ توان خروجی اثرگذار است و قلهٔ توان در ولتاژ ۵۵ کیلوولت بهدست میآید. همچنین با تغییر ظرفیت خازن ذخیره از ۳۰ تا ۹۰ نانوفاراد،

بیشینه توان خروجی در ظرفیت خازن ۵۲ بهدست می آید. در نهایت نمودار دینامیکی آهنگ گسست مولکول کربن دی اکسید بر حسب زمان در شکل ۱۰ داده شده است که در زمانی از مرتبهٔ ۴ میکروثانیه به حالت اشباع می رسد. همانطور که از این شکل مشاهده می شود در کسری از ثانیه بخشی از مولکول-این شکل مشاهده می شود در کسری از ثانیه بخشی از مولکول-دیگری تبدیل می شود که این گونههای مولکولی و یونی فراوان دیگری تبدیل می شود که این گونهها سبب ناپایداری محیط تخلیهٔ الکتریکی، کاهش طول عمر لیزر و توان خروجی لیزر می شوند [۱۶]. بر اساس گزارش اسمیت، چنانچه غلظت درصد گازهای CO به ۲۲٪ و ۲۰ به ۴٪ برسد توان خروجی لیزر نصف خواهد شد [۲۳].

از نقطه نظر عملی، برای جلوگیری از افت توان خروجی لیزرو افزایش طول عمر آن معمولاً از کاتالیستهای همگن گازی ۲۲ ، H<sub>Y</sub>O و... و یا کاتالیستهای ناهمگن جامد مانند Pd و Pt تلقیح شده بر روی ۲O۲ استفاده می شود [۲۴ و ۲۵].



حاكم. بر تخليه.

شکل ۸ نمودارقلهٔ توان خروجی بر حسب ظرفیت خازن ذخیره.

### ۵. نتیجهگیری

به منظور بیشینه کردن توان خروجی یک لیزر TEA COr، مدل سينتيک شش دمايي بر اساس معادلات توسعه يافتهٔ لاندائو -تلر با معادلات حاکم بر محیط تخلیهٔ الکتریکی جفت شدند و به روش رانگ-کوتای مرتبهٔ ۴ به صورت عددی حل شدهاند. در محاسبات تفکیک مولکول CO<sub>۲</sub> به CO نیز به صورت یک معادلهٔ تحول زمانی درنظر گرفته شد و با سایر معادلات جفت شد. تفکیک مولکول CO<sub>۲ -</sub> به CO تا پیش از این پژوهش، صر فاً به صورت یک مقدار ثابت و به صورت دستی در معادلات سینتیک لیزر CO<sub>۲</sub> وارد می شد. که منطبق بر واقعیت حاکم بر ليزر تيم، TEA COr بسته نيست. سيس رفتار زماني جريان و ولتاژ تخلیه و قلهٔ توان تپ خروجی لیزر، در آمیزهٔ گازی با نسبت ۱:۱:۳ بهدست آمد. همچنین مقادیر بهینه برخی پارامترهای لیزر همانند بازتابندگی آینهٔ خروجی، ظرفیت خازن ییش یونش و ظرفیت و ولتاژ شارژ خازن ذخیره برای بهدست آوردن بيشينه قله توان خروجي نيز محاسبه شد. نتايج بهدست-آمده، راهنمای خوبی برای طراحی بهینه نوسانگرهای COr TEA است.





مراجع

- 1. D C Dumitras, "CO<sub>2</sub> laser: Optimisation and application" (2012).
- 2. W J Witteman, "The CO<sub>2</sub> laser", Springer (2013).
- 3. T Omi and K Numano, Laser therapy 23, 1 (2014) 49.
- 4. H Fenske and T Czotscher, Lasers in Manufacturing and Materials Processing 7, 1 (2020) 1.
- 5. M Momcilovic, S Zivkovic, J Petrovic, I Cvijovic-Alagic and J Ciganovic, Appl. Phys. B 125, 11 (2019) 1.
- 6. M Momcilovic, J Petrovic, J Ciganovic, I Cvijovic-Alagic, F Koldzic, and S Zivkovic, *Plasma Chem. and Plasma Process.* **40**, 2 (2020) 499.
- 7. A Pezh, Optics Commun. 515 (2022) 128187.
- 8. X Li, H Wang, W Yu, L Wang, D Wang, H Cheng, and L Wang, Optik 241 (2021)167036.
- 9. K Luk, I S Zhao, N Gutknecht, and C H Chu, Lasers in Dental Science 3, 1 (2019) 1.
- 10. M Kumar, V Gupta and A Nath, Appll. Phys. B 80, 6 (2005) 757.
- 11. M Kumar, A Deshpande, C Gupta, A Biswas, and A Nath, J. of Chem. Sci. 114, 6 (2002) 659.
- 12. W Fuß, J Göthel, M Ivanenko, W Schmid, P Hering, K Kompa, and K Witte, Isot. Environ. and Health Stud. 30, 2-
- 3 (1994) 199. 13. A Bahrampour and A Askari, *Optics comm.* **257**, 1 (2006) 97.
- 14. A Karapuzikov, A Malov, and I Sherstov, Infrared Phys. Tech. 41, 2 (2000) 77.
- 15. S S Milijanic, N N Stjepanovic, and M S Trtica, presented at the High-Power Lasers in Civil Engineering and Architecture, 2000 (unpublished).
- 16. H Hokazono and H Fujimoto, J. of appll. phys. 62, 5 (1987) 1585.

- 17. M Kumar, A Biswas, P Bhargav, T Reghu, S Sahu, J Pakhare, M Bhagat and L Kukreja, *Opt. Laser Technol.* **52** (2013) 57.
- 18. M Kumar, J Khare, C Gupta, and A Nath, Opt. Laser Technol. 39, 1 (2007) 129.
- 19. B A Ghani, Comp. phys. commun. 171, 2 (2005) 93.
- 20. R Torabi, H Saghafifar, A Koushki and A Ganjovi, Phys. Scr. 91, 1 (2015) 015501.
- 21. R Torabi, H Saghafifar, and A Koushki, Optik 135 (2017) 238.
- 22. M Soukieh, B A Ghani, and M Hammadi, Opt. Laser Technol. 30, 8 (1998) 451.
- 23. A Smith, T Bett, and P Browne, IEEE J. Quantum Electron. 11, 7 (1975) 335.
- 24. H Hokazono, N Kobayashi, M Obara, K Midorikawa, and H Tashiro, IEEE J. Quantum Electron. 28, 8 (1992) 1792.
- 25. M Zand, A Koushki, R Neshati, B Kia, and K Khorasani, Laser Phys. 28, 2 (2018) 025002.